



	<h2 style="color: #E67E22;">GP1M009A090FH</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">GP1M009A090FH</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 900V 9A TO220F
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">GP1M009A090FH.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 2400 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		



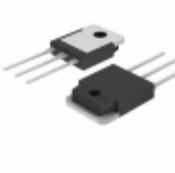





### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">GP1M009A090FH</a>
Hersteller	<a href="#">Global Power Technologies Group</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 9A TO220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2400 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 4.5A, 10V
Verlustleistung (max)	48W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2324pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)

GP1M009A090FH Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M009A090FH-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M009A090FH Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M009A090FH E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>GP1M010A080FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 9.5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M010A060H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 10A TO220</p>	 <p><b>GP1M009A090N</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9.5A TO3PN</p>	 <p><b>GP1M009A070F</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 9A TO220F</p>
 <p><b>GP1M009A050FSH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8.5A TO220F</p>	 <p><b>GP1M010A060FH</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 10A TO220F</p>	 <p><b>GP1M009A090H</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9A TO220</p>	 <p><b>GP1M009A050HS</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 8.5A TO220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M009A090FH Global Power Technologies Group	GP1M009A090FH Datenblatt	GP1M009A090FH-Datenblätter	GP1M009A090FH PDF	Global Power Technologies Group GP1M009A090FH
GP1M009A090FH Electronic	GP1M009A090FH-Komponenten	GP1M009A090FH-Verteiler	GP1M009A090FH-Bild	GP1M009A090FH-Teil
GP1M009A090FH Preis	GP1M009A090FH Hersteller	GP1M009A090FH Bild	GP1M009A090FH Aktie	GP1M009A090FH Inventar
GP1M009A090FH Neu	GP1M009A090FH Original	GP1M009A090FH garantiert	GP1M009A090FH RFQ	GP1M009A090FH Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited